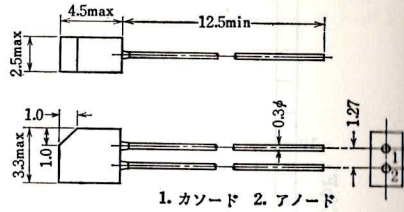


1S1473H

シリコン
エピタキシャルプレーナ形
高速度スイッチング用



■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

逆電圧	V_R	-30 V
平均整流電流	I_O	100 mA
せん頭順電流	$i_F(\text{peak})$	300 mA
サージ順電流*	$I_F(\text{surge})$	600 mA
許容損失	P	100mW
接合部温度	T_j	125 $^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125 $^\circ\text{C}$

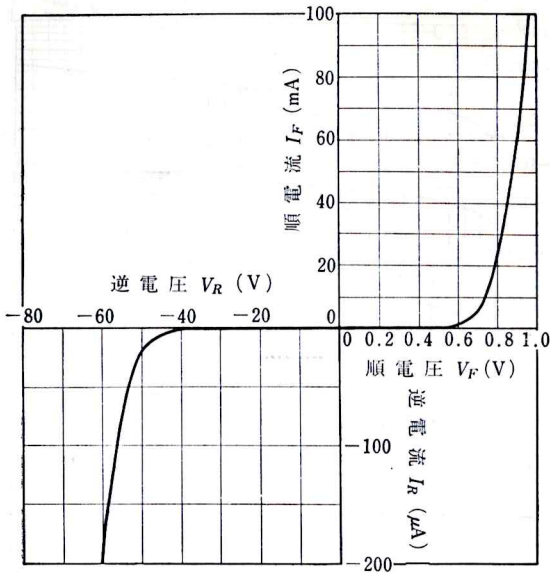
* 持続時間 1sec 以内のサージ電流における許容値。

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

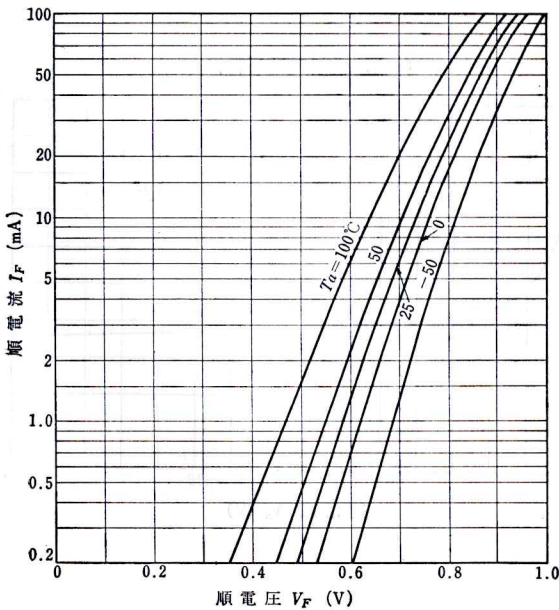
		最小	標準	最大
逆破壊電圧	BV_R ($I_R=-5\mu\text{A}$)	-30	—	— V
順電圧	V_F ($I_F=10\text{mA}$)	0.64	0.73	0.80 V
逆電流	I_R ($V_R=-20\text{V}$)	—	-15	-100 nA
接合容量	C ($V_R=-1\text{V}, f=1\text{Mc}$)	—	0.75	3.5 pF
逆回復時間*	t_{rr} ($I_F=-I_R=10\text{mA}$)	—	—	4 ns

* 逆回復時間測定回路は 1S1219H を参照。

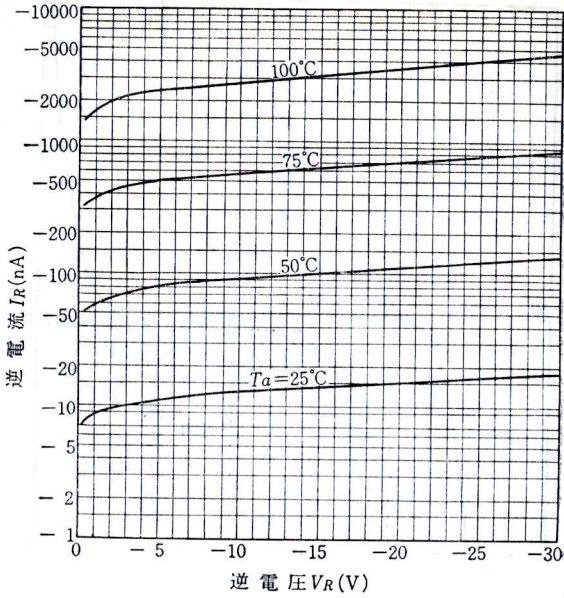
靜 特 性



順 特 性



逆 特 性



接合容量对逆电压特性

